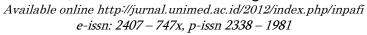
JURNAL EINSTEIN



Jurnal Hasil Penelitian Bindang Fisika





KAJIAN TEORETIK UNTUK MENENTUKAN INDEKS BIAS DARI SEMIKONDUKTOR COPPER-PHTHALOCYANINE BERDASARKAN CELAH ENERGINYA

Alkhafi Maas Siregar dan Novi Febrina S

Jurusan Fisika Universitas Negeri Medan

Email: alkhafi@unimed.ac.id

Diterima September 2017; Disetujui Oktober 2017; Dipublikasikan November 2017

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan indeks bias semikonduktor *Cu-Phthalocyanine* berdasarkan celah energinya. Penentuan indeks bias menggunakan metode semi empiris ZINDO/I dan perhitungan menggunakan pemrograman matlab. Pemodelan struktur diperoleh dengan memberikan masukan, yaitu unsur, senyawa, dan jumlah atom. Optimasi dilakukan menggunakan energi HOMO dan LUMO untuk memperoleh celah energi. Dengan menggunakan Persamaan Moss, Ravindra et al, Herve-Vandamme, Reddy, dan Kumar- Singh, nilai celah energi dapat menentukan nilai indeks bias. Pada energi 3,854757 eV untuk HOMO dan 3,538368 eV untuk LUMO, diperoleh celah energi 0,3164eV. Untuk menentukan nilai indeks bias, celah energi digunakan pada persamaan yang sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan ketentuan dari setiap persamaan, nilai indeks bias yang sesuai pada celah energi 0,3164 eV adalah indeks bias dari persamaan Moss, dengan nilai indeks bias yaitu 4,1627.

Kata kunci: semikonduktor, phthalocyanine, celah energi, indeks bias

PENDAHULUAN

Pada saat ini, perkembangan elektronika mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam dunia modern. Kemajuannya terjadi setelah ditemukannya komponen semikonduktor (zat padat) yang memberikan banyak sifat-sifat listrik yang dapat memecahkan persoalan elektronika (Rio dan Lida. Semikonduktor terdiri dari ikatan kovalen dari elektron bebas. Berdasarkan elektron suatu atom yang bebasnya, dikatakan semikonduktor harus memiliki elektron bebas sebanyak empat elektron valensi (Malvino, 1985). Elektron bebas tidak dapat bergerak

secara bebas. Oleh karena itu elektron bebas harus menerima energi dari luar agar dapat membatasi pergerakan dalam atom. Cara agar elektron bebas dapat bebas adalah dengan memberi elektron suatu celah energi (Rio dan Lida, 1980).

Berdasarkan jenis bahannya, semikonduktor terdiri dari dua bagian yaitu semikonduktor anorganik dan semikonduktor organik. Semikonduktor anorganik adalah semikonduktor yang terbuat dari logam. Semikonduktor organik adalah semikonduktor yang harus digabung dengan logam yang memiliki energi ionisasi kecil akan mudah melepaskan elektron pada saat

disatukan dengan bahan organik, semakin mudah melepaskan elektron, maka sifat konduktivitasnya akan bertambah (Hikmah, 2014).

Salah satu bahan organik yang digunakan dalam pembuatan semikonduktor organik adalah *phthalocyanine*. *Phthalocyanine* adalah bahan yang memiliki kemampuan untuk menyerap foton dari sinar matahari pada panjang gelombang sinar yang tampak. Untuk memaksimalkan penyerapan foton, maka *phthalocyanine* harus di konjugasi dengan logam. Logam yang dipilih adalah logam yang memiliki energi ionisasi lebih kecil sehingga mudah melepaskan elektron pada saat disatukan dengan bahan organik. Tembaga (Cu) adalah salah satu logam yang mudah melepaskan elektron.

Suatu bahan dapat disebut bahan semikonduktor apabila celah energinya Eg < 6eV (Oktaviani dan Astuti, 2014). Pada semikonduktor, kulit yang terisi elektron disebut *Highest Occupied Molecular Orbital* (HOMO) dan kulit yang tidak terisi disebut *Lowest Unoccupied Molecular Orbital* (LUMO). Selisih dari kedua energi tersebut dinamakan celah energi. Celah energi mencerminkan perbedaan tingkatan energi antara Energi HOMO dan Energi LUMO, yang dinyatakan dengan:

$$Eg = E_{LUMO} - E_{HOMO}$$
 (1)

Еномо : Energi pada kulit yang terisi elektronЕцимо : Energi pada kulit yang tidak terisi elektron

Eg : Celah energi (Sholihun, 2009).

Indeks bias dan celah energi adalah dua kuantitas penting yang menentukan perilaku optik dan elektronik semikonduktor. Indeks bias dapat menurun dengan celah energi. Indeks bias material diketahui menurun dengan celah energi karena dua kuantitas material diyakini memiliki korelasi tertentu.

Moss membuat upaya pertama yang saling berhubungan untuk indeks bias dan celah energi dalam semikonduktor dan memberikan hubungan yang umum sebagai,

$$n^4 Eg = 95eV (2)$$

dimana n adalah indeks bias optik dan Eg adalah celah energi. Hubungan ini akan mendapatkan nilai indeks bias dengan nilai celah energi yaitu 0,17eV < Eg < 3,68eV. Sebuah artikel meneliti tentang pernyataan hubungan ini, sehingga Ravindra et al mengusulkan hubungan linear yang mengatur indeks bias dengan celah energi antara ikatan satu dengan yang lain sebagai,

$$n = 4,084 - 0,62Eg \tag{3}$$

Hubungan ini menjadi satu linier pada celah energi yaitu 1,5eV < Eg < 3,5eV dan dapat menyimpang pada nilai celah energi yang lebih tinggi. Berdasarkan teori getaran, Herve dan Vandamme mengusulkan hubungan untuk indeks bias sebagai,

$$n^2=1 + (A/(E_g+B))^2$$
 (4)

dimana A adalah energi ionisasi hidrogen = 13,6eV dan B = 3,4eV adalah konstan. Pada semikonduktor golongan II-VI, hubungan ini dapat memperoleh nilai indeks bias dengan nilai celah energi yaitu 2eV < Eg < 4eV. Hubungan ini gagal untuk memprediksi nilai indeks bias pada nilai celah energi yang rendah, yaitu Eg < 1,4eV.

Reddy mengusulkan hubungan indeks bias sebagai,

$$n^4(Eg - 0.365) = 154$$
 (5)

yang dimana hubungan ini merupakan modifikasi dari hubungan Moss. Hubungan ini memberikan nilai eksperimental untuk celah energi yaitu 1,1eV < Eg < 6,2eV. Hubungan ini tidak dapat digunakan (tidak valid) untuk celah energi Eg < 0,365eV.

Kumar dan Sing juga memberikan hubungan indeks bias sebagai,

$$n = K Eg^{C}$$
 (6) dimana $K = 3.3668 dan C = -0.32234$.

Dengan hubungan ini, indeks bias dapat diperoleh dengan celah energi yaitu 2eV < Eg < 4eV (Bahadur dan Mishra, 2013).

Penentuan indeks bias untuk semikonduktor telah diteliti oleh Tripathy (2015) dengan metode eksperimen. Tripathy melakukan pengukuran indeks bias pada senyawa halida alkali untuk semikonduktor menggunakan relasi empiris berdasarkan celah energi yang kemudian diterapkan ke biner serta semikonduktor terner untuk

berbagai celah energi. Relasi Ravindra mendapatkan nilai indeks bias 4,1 untuk semikonduktor memiliki celah energi lebih besar dari 6,587 eV; Relasi Herve-Vandamme pada nilai celah energi yang rendah (Eg < 1,4 eV) gagal untuk memprediksi nilai indeks bias secara eksperiment, untuk Eg>1,4eV Herve mendapat nilai indeks bias yaitu 3,9; Relasi Moss dapat memprediksi nilai indeks bias yaitu 0,17eV<Eg<3,68eV dari celah energi, dan mendapatkan nilai indeks bias yaitu 5,6.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang penentuan indeks bias berdasarkan celah energi, semikonduktor dengan metode eksperimen telah mendapatkan hasil namun belum sesuai. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang sesuai, penelitian tentang penentuan indeks bias berdasarkan celah energi semikonduktor organik akan dilakukan dengan metode komputasi. Karena berdasarkan penelitian tentang semikonduktor yang menggunakan metode komputasi didalam penelitian suatu semikonduktor akan lebih menarik, lebih mudah, lebih hemat, dan mendapatkan hasil yang lebih sesuai.

METODE PENELITIAN

Perhitungan dilakukan menggunakan laptop dengan spesifikasi 1.60GHz, dan Random Access Memory (RAM) 2,00 GB dengan sistem operasi Windows 10 pro, Program hyperchem digunakan untuk memodelkan *Cu-phthalocyanine* dan program Matlab untuk membuat interface.

Memodelkan *Cu-Phthalocyanine* dilakukan di hyperchem, untuk melakukan proses perhitungan celah energi, dilakukan proses optimasi geometri terlebih dahulu, kemudian perhitungan Ehomo dan Elumo. Setelah diperoleh Ehomo dan Elumo, maka nilai celah energi dapat diperoleh dengan menghitung selisih dari nilai Ehomo dan Elumo. Selanjutnya membuat interface pada Matlab. Membuat kode yang digunakan untuk menghitung nilai indeks bias, yaitu:

Persamaan Moss:

$$n^4Eg = 95eV$$

Persamaan Ravindra et all.:

$$n = 4.084 - 0.62Eg$$

Persamaan Herve-Vandamme:

$$n^2 = 1 + (A/(Eg + B))^2$$

Dimana A adalah energi ionisasi hidrogen 13,6 eV dan B=3,47 eV adalah konstan Persamaan Reddy :

$$n^4(Eg - 0.365) = 154$$

Persamaan Kumar dan Singh:

$$n = K Eg^{C}$$

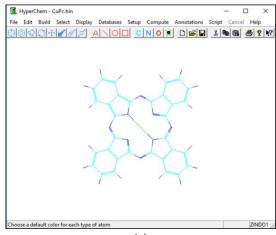
Dimana K = 3.3668 dan C = -0.32234

Setelah perancangan interface selesai, selanjutnya menghitung nilai celah energi dengan menginput nilai celah energi pada kolom yang tersedia pada interface, lalu menekan tombol hasil pada interface. Sehingga diperoleh nilai indeks bias masingmasing persamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

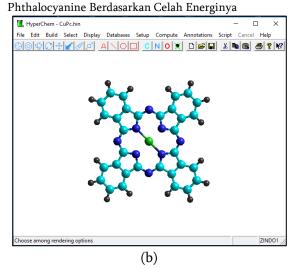
A. Kajian Optimasi Geometri *Cu-Phthalocyanine*

Pemodelan molekul dilakukan dengan menggunakan *software* hyperchem versi 8.0. Pembuatan struktur dilakukan dengan menginput data penyusun senyawa *Cu-Phthalocyanine* yaitu : 1 atom Tembaga (Cu), 32 atom Karbon (C), 18 atom Hidrogen (H), dan 8 atom Nitrogen (N).



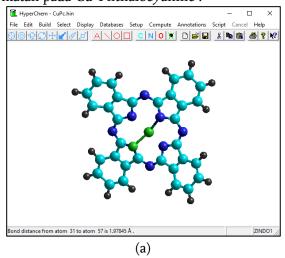
(a)

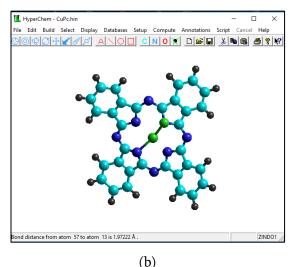
Alkhafi Maas Siregar dan Novi Febrina S, Kajian Teoretik Untuk Menentukan Indeks Bias Dari Semikonduktor Copper-



Gambar 1. Bentuk Cu-Phthalocyanine (a) Kompleks 2D; (b) Kompleks 3D.

Phthalocyanine terkonjugasi Tembaga (Cu) termasuk senyawa kompleks. Syarat suatu senyawa dikatakan kompleks apabila memiliki panjang ikatan antara atom pusat dengan atom lainnya hampir bersamaan. Panjang ikatan antar atom dapat ditampilkan dengan cara pilih 2 atom yang akan dihitung panjangnya, klik Select lalu pilih Select Sphere, maka panjang ikatan ditampilkan pada sudut kiri lembar kerja hyperchem, begitu juga dalam menampilkan sudut ikatan atom. Berikut data panjang ikatan pada *Cu-Phthalocyanine*:



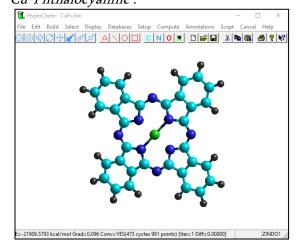


Gambar 2. Panjang ikatan (a) Cu (57) – N (31); (b) Cu (57) – N (13)

Tabel 1. Panjang Ikatan *Cu- Phthalocyanine*

Atom yang Terlibat	Panjang Ikatan (Å)
Cu (57) - N (31)	1,97845
Cu (57) - N (13)	1,97222

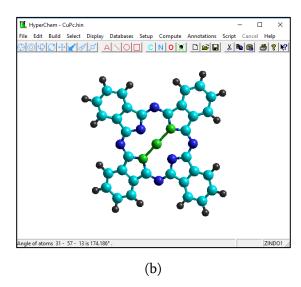
Setelah pembuatan Cu-Phthalocyanine dalam tiga dimensi, Cusenyawa Phthalocyanine dioptimasi dengan menggunakan metode ZINDO/1 dengan cara klik compute pada menu bar, lalu pilih optimation geometry. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan struktur yang paling stabil dengan tingkat energi yang lebih minimum. Berikut hasil optimasi geometri Cu-Phthalocyanine:



Gambar 3. *Cu-Phthalocyanine* teroptimasi

Sudut ikatan berpengaruh dalam distribusi elektron pada suatu molekul dan fleksibilitas

molekul. Sudut ikatan adalah sudut yang terbentuk oleh atom pusat dengan dua atom di sekelilingnya. Semakin besar sudut yang dibentuk maka semakin kurang fleksibel molekul yang terbentuk. Molekul yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi memungkinkan untuk dibentuk sangat tipis sebagai bahan semikonduktor.

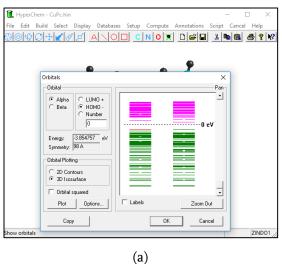


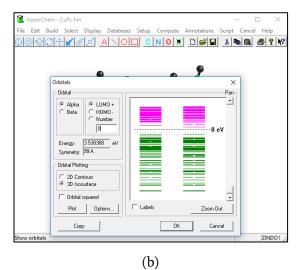
Gambar 4. Sudut Ikatan Cu dan N (a) Sebelum Optimasi; (b) Sesudah Optimasi

Tabel 2. Besar Sudut Ikatan

	Besar Sudut (°)	
Atom yang Terlibat	Sebelum	Sesudah
	Optimasi	Optimasi
N (31) – Cu (57) – N	156,374°	174,186°
(13)		

Setelah teroptimasi, selanjutnya perhitungan celah energi dapat dilakukan dengan cara klik compute lalu pilih orbital, maka energi LUMO dan energi HOMO akan ditampilkan. Menentukan celah energi *Cu-Phthalocyanine* diperoleh dari selisih energi HOMO dengan energi LUMO. Adapun energi HOMO dan energi LUMO yang dihasilkan adalah sebagai berikut:





Gambar 5. Tingkatan Energi HOMO-LUMO (a) Energi HOMO; (b) Energi LUMO.

B. Celah Energi

Menghitung celah energi digunakan metode semi empiris ZINDO/1. Celah energi merupakan perbedaan tingkatan energi antara energi LUMO terhadap energi HOMO, yang dinyatakan dengan:

Egap = Elumo-Ehomo

Tabel 3. Nilai Celah Energi

Jumlah Atom				Celah		
			Energi Energi HOMO LUMO		Energi (<i>Eg</i>)	
C H N Cu	Cu	помо	LOMO	$E_{LUMO} - E_{HOMO}$		
32	18	0	1	3,8547	3,5383	0,3164
32	10	0	1	57eV	68eV	eV

Dari data tersebut dapat diketahui besar celah energi *Cu-Phthalocyanine*,

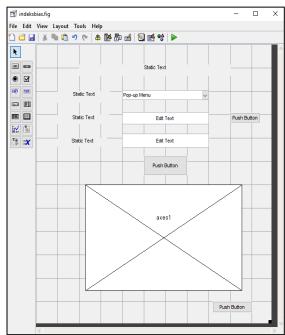
Egap = Elumo-Ehomo

Egap = |3,538368-3,854757|

Egap = 0.3164eV

C. Interface

Dalam perancangan sebuah figure GUI, dibutuhkan beberapa komponen yang dapat mendukung proses penentuan hasil suatu GUI. Dalam penentuan indeks bias, penulis menggunakan beberapa komponen yaitu 4 static text yang digunakan untuk judul, persamaan, celah energi, dan nilai indeks bias; 2 edit text yang digunakan untuk mengisi nilai celah energi dan menampilkan hasil dari nilai indeks bias; 1 popupmenu untuk membuat pilihan tampilan dari setiap persamaan; 3 pushbutton untuk menampilkan tindakan jika diklik untuk hasil, grafik dan keluar; 1 axes untuk menampilkan grafik.



Gambar 6. Rangcangan GUI

Setelah membuat rancangan GUI, selanjutnya mengatur layout Komponen.

Tabel 4. Property Inspector

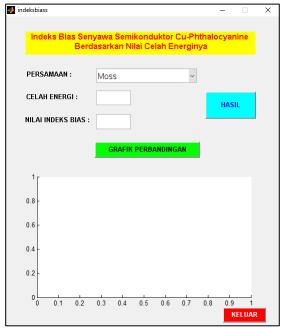
Vommon	Property Inspector			
Kompon en	Font Size	Font Weight	String	Tag
Static text1	12	Bold	Graphic al User Interfac e (GUI) Matlab Indeks Bias terhada p Celah Energi Cu- Phthalo cyanine	Text1
Static text2	10	Bold	Persama an	Text2
Static text3	10	Bold	Celah Energi	Text3
Static text4	12	Bold	Nilai Indeks Bias	Text5
Edit	10	Normal		Eg

Alkhafi Maas Siregar dan Novi Febrina S, Kajian Teoretik Untuk Menentukan Indeks Bias Dari Semikonduktor Copper-

Phthalocyanine Berdasarkan Celah Energinya

Tittiaiocyani	ne berau	Sarkan Celan	Lineiginiya	1
text1				
Edit text2	12	Bold		N
Popupm enu	12	Normal	Moss Ravindr a et al Herve- Vandam me Reddy Kumar dan Singh	data_ popu p
Pushbut ton1	10	Bold	Hasil	hasil _pus hbutt on
Pushbut ton2	10	Bold	Grafik Perband ingan	grafi k_pu shbut ton
Pushbut ton3	10	Bold	Keluar	tkelu ar
Axes	10	Normal	-	axes1

Selanjutnya mengaktifkan GUI dengan memilih **RUN** dari menu **Tools**.



Gambar 7. Tampilan GUI

D. Indeks Bias

Pada penelitian ini untuk menghitung indeks bias berdasarkan celah energi digunakan lima persamaan yang saling berkaitan.

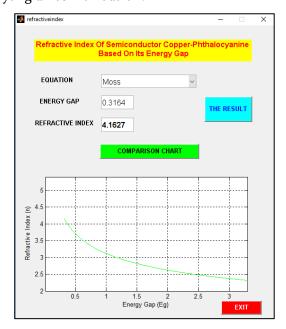
Indeks bias yang diperoleh dari persamaan Moss sesuai, karena celah energi Eg yang dihasilkan untuk memperoleh nilai indeks bias berada pada kisaran 0,17eV < Eg < 3,68eV dan tidak berada pada Eg < 0,17eV. Indeks bias yang diperoleh dari persamaan Ravindra tidak sesuai, karena indeks bias tidak akan sesuai jika nilai dari celah energi Eg < 6,587eV. Indeks bias yang diperoleh dari persamaan Herve-Vandamme tidak sesuai, karena indeks bias tidak akan sesuai jika nilai dari celah energi Eg < 1,4eV. Indeks bias yang diperoleh dari persamaan Reddy tidak sesuai, karena indeks bias tidak akan sesuai jika nilai dari celah energi Eg < 0,365eV. Indeks bias yang diperoleh dari persamaan Kumar dan Singh tidak sesuai, karena indeks bias tidak akan sesuai jika nilai dari celah energi tidak berada pada kisaran 2eV < Eg < 4Ev.

Tabel 5. Indeks bias yang sesuai

Referensi	Persamaan	Celah	Deskripsi
		Energi	
		0,17 <	
	Moss	Eg <	Valid
		3,68 eV	
0,3164 eV	Ravindra et al	Eg >	Not
		6,587	Valid
		eV	v allu
	Herve-	Eg > 1,4	Not
	Vandamme	eV	Valid
	Reddy	1,1 < Eg	Not
		< 6,2 eV	Valid
	Kumar-	2 < Eg <	Not
	Singh	4 eV	Valid

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai indeks bias yang sesuai berdasarkan nilai celah energi adalah indeks bias dari

persamaan Moss. Sehingga nilai indeks bias yang dihasilkan adalah:



Gambar 8. Indeks bias berdasarkan Persamaan Moss

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa copper phthalocyanine merupakan suatu semikonduktor organik, yang memiliki rumus kimia yaitu C32H16CuN8, dengan nilai celah energi 0,3164eV dan indeks bias yaitu 4,1627.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Zamroni., (2013), Pengukuran Indeks Bias Zat Cair Melalui Metode Pembiasan Menggunakan Plan Pendidikan Paralel, IPA, Konsentrasi Fisika, Program Universitas Pascasarjana Negeri Semarang, *Jurnal Fisika* Vol. 3 No. 2.

Bahadur dan Mishra., (2013), Correlation

Between Refractive Index and

Electronegativity Difference for

ANB8-N Type Binary

Semiconductors, ACTA PHYSICA

POLONICA Vol.123, India.

Hikmah, Aulia dan Utomo, Suryadi Budi., (2014), Kajian Teoritis untuk Menentukan Celah Energi Kompleks Ag-Phthalocyanine dengan Menggunakan Metode Mekanika

Kuantum Semiempiris Zindo/1, Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia VI.

Malvino, A. A., (1985), Aproksimasi Rangkaian Semikonduktor Pengantar Transistor dan Rangkaian Terpadu, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Oktaviani, Yolanda dan Astuti., (2014),
Sintesis Lapisan Tipis
Semikonduktor Dengan Bahan Dasar
Tembaga (Cu) Menggunakan
Chemical Bath Deposition, Jurnal
Fisika Unand Vol. 3, No. 1.

Pranowo, Harno Dwi., (2009), *Kimia Komputasi*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Pratiwi, Agustin., (2015), Analisis Perubahan Kadar Logam Tembaga (Cu) pada Penambahan Ion Perak (Ag) dengan Metode Elektrokoagulasi. *Jurnal Kimia Mulawarman* Vol. 13 No. 1.

Rio, S. Reka dan Iida, Masamori., (1980),

*Fisika Dan Teknologi

Semikonduktor, Penerbit P.T.

Pradnya Paramita, Jakarta.

Sahid, (2006), *Panduan Praktis MATLAB*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Sholihun, (2009), Komputasi Parameter
Internal Sel Surya Organik dan
Penentuan Pola Keterikatannya
Terhadap Intesitas Menggunakan
Metode LANBV, Tesis, FMIPAUGM, Yogyakarta.

Triphaty, (2015), Refractive Indices of Semiconductors from Energy gaps,
Department of Physics, Indira
Gandhi Institute of Technology,
Sarang, Dhenkanal, Odisha-759146,
India.

Zenkevich, E. I., Gaponenko, S. V., Sagun, E.I dan Von, Borczyskowki, (2013), Bioconjugates Based On Semiconductor Quantum Dots And Ligands: Properties, Porphyrin Excition Relaxation Pathways And Singlet Oxigen Generation Efficiency For PDT Applications, National Technical University of Belarus, Nezavisimosti Ave.

Zerner, M., (1991), *Review in Computational Chemistry*, Eds. K.B Lipkowitz and

D. Boyd, VCH 313-320.